

多機能走査型X線光電子分光分析装置 PHI VersaProbe4

製造元	アルバック・ファイ株式会社 購入年度：2022年度
仕様	走査型X線源（単色化 AlK α 線、ビーム径を直径 10～200 μ m に設定可能。10 μ m から 1.4mm×1.4mm まで走査可能）、Mg/Al デュアルアノードX線源、Ar イオン銃、Ar ガスクラスタイオン銃、He 紫外線源、帯電中和・低エネルギー逆光電子分光分析用電子銃、反射電子エネルギー損失分光分析用電子銃、トランスファーベッセル、加熱冷却ステージ（500～－120℃）
保有部署	材料工学専攻
設置場所	吉田・工学部物理系校舎・地下1階002室
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/20210210-zaiko
注意事項等	事前講習を受講のうえ、利用者自身で測定してください。 所属機関において、X線業務従事者として登録済であることを確認してください。 利用目的、試料情報（形状、サイズ、含有元素、導電性の有無）を下記連絡先にお知らせください。 粉末試料は利用不可です。真空中（10 ⁻⁷ Pa）で安定な固体試料が測定対象です。 厚さ 2mm 以下で 5mm×5mm から 12mm×16mm までの試料が主な測定対象ですが、上記範囲外のサイズでも測定可能な場合がありますのでご相談ください。
連絡先	材料工学専攻 ナノ構造学研究室 准教授 野瀬 嘉太郎 075-753-5472 nose.yoshitaro.5e@kyoto-u.ac.jp 材料工学専攻 教育研究支援室 技術職員 佐々木 宣治 075-753-5426 sasaki.nobuharu.7a@kyoto-u.ac.jp ※メールは両名にお送りください。
キーワード	XPS、UPS、LEIPS、REELS 、固体表面分析、化学状態分析、深さ方向分析
機器コード	0000103006
自由記入欄	固体表面 10nm 程度の深さの化学結合状態や組成に関する情報を得る X 線光電子分光分析装置です。X 線照射による光電子分光の他、紫外光電子分光分析（UPS）、

低エネルギー逆光電子分光分析（LEIPS）、反射電子エネルギー損失分光分析（REELS）を行えます。また、通常の Ar イオン銃に加えて Ar ガスクラスターイオン銃を備えているため、種々の材料に対してエッチングによる深さ方向分析が可能です。専用のトランスファーベッセル、4 端子付き試料加熱冷却機構も備えており、オペランド測定などにも対応できます。

